

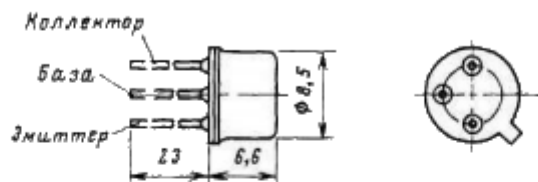
## КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Е

Транзисторы кремниевые планарные *n-p-n* усилительные высоко-  
частотные

Предназначены для усилительных и импульсных схем

Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами  
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса

Масса транзистора не более 2 г



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим  
эмиттером при  $U_{КЭ} = 10$  В,  $I_K = 150$  мА

при  $T = 298$  К

КТ630А . . . . .	.40 - 120
КТ630Б . . . . .	.80 - 240
КТ630В, КТ630Г . . . . .	.40 - 120
КТ630Д . . . . .	.80 - 240
КТ630Е . . . . .	.160 - 480

при  $T = 398$  К

КТ630А . . . . .	.40 - 240
КТ630Б . . . . .	.80 - 480

при  $T = 213$  К

КТ630А . . . . .	.15 - 120
КТ630Б . . . . .	.30 - 240

Граничное напряжение при  $I_3 = 100$  мА,  $\tau_n \leq 300$  мкс,

$Q \geq 200$  не менее

КТ630А . . . . .	90 В
КТ630Б . . . . .	80 В
КТ630В . . . . .	100 В
КТ630Г . . . . .	60 В
КТ630Д, КТ630Е . . . . .	50 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при  $I_K =$   
 $= 150$  мА,  $I_B = 15$  мА не более . . . . .

0,3 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при  $I_K = 150$  мА,  
 $I_B = 15$  мА не более . . . . .

1,1 В

Граничная частота коэффициента передачи тока в  
схеме с общим эмиттером при  $U_K = 10$  В,  
 $I_K = 60$  мА не менее . . . . .

50 МГц

Емкость коллекторного перехода при  $U_{КБ0} = 10$  В  
не более . . . . .

15 пФ

Емкость эмиттерного перехода при  $U_{ЭБ0} = 0,5$  В  
не более . . . . .

65 пФ

Входное сопротивление в схеме с общей базой в

режиме малого сигнала* при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 5$ мА, $f = 270$ Гц . . . . .	5–8 Ом
Входное сопротивление в схеме с общим эмит- тером в режиме малого сигнала при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_К = 5$ мА, $f = 270$ Гц . . . . .	200–1200 Ом
типовое значение . . . . .	500* Ом
Время включения* при $I_К = 200$ мА, $I_Б = 40$ мА, $\tau_{в} = 10$ мкс . . . . .	0,04–0,25 мкс
типовое значение . . . . .	0,1* мкс
Время выключения* при $I_К = 200$ мА, $I_Б = 40$ мА, $\tau_{в} = 10$ мкс . . . . .	0,08–0,5 мкс
типовое значение . . . . .	0,25* мкс
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $I_К = 100$ мкА $R_{ЭБ} = 3$ кОм не менее:	
КТ630А, КТ630Б . . . . .	120 В
КТ630В . . . . .	150 В
КТ630Г . . . . .	100 В
КТ630Д, КТ630Е . . . . .	60 В
Постоянное напряжение база-эмиттер при $I_3 = 100$ мкА не менее:	
КТ630А, КТ630Б, КТ630В . . . . .	7 В
КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е . . . . .	5 В
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} = 3$ кОм КТ630А, КТ630В при $U_{КЭ} = 80$ В; КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е при $U_{КЭ} = 40$ В не более . . . . .	1 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 5$ В не более . . . . .	0,1 мкА

#### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} =$ $= 3$ кОм:	
КТ630А, КТ630Б . . . . .	120 В
КТ630В . . . . .	150 В
КТ630Г . . . . .	100 В
КТ630Д, КТ630Е . . . . .	60 В
Постоянное напряжение коллектор-база:	
КТ630А, КТ630Б . . . . .	120 В
КТ630В . . . . .	150 В
КТ630Г . . . . .	100 В
КТ630Д, КТ630Е . . . . .	60 В
Постоянное напряжение эмиттер-база КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д . . . . .	7 В
Постоянный ток коллектора КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е . . . . .	1 А
Импульсный ток коллектора КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е . . . . .	2 А
Постоянный ток базы КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е . . . . .	0,2 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 233 - 298$ К КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е . . . . .	0,8 Вт
при $T = 358$ К КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е . . . . .	0,2 Вт
Температура перехода . . . . .	398 К
Температура окружающей среды . . . . .	От 233 до 358 К

Примечание Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора при температуре не более 533 К в течение не более 3 с Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом изгиба 1,5–2 мм